

2SC922

NPN エピタキシャル形シリコントランジスタ / NPN Epitaxial Silicon Transistor

FM チューナ用 / FM Tuner

特 徴

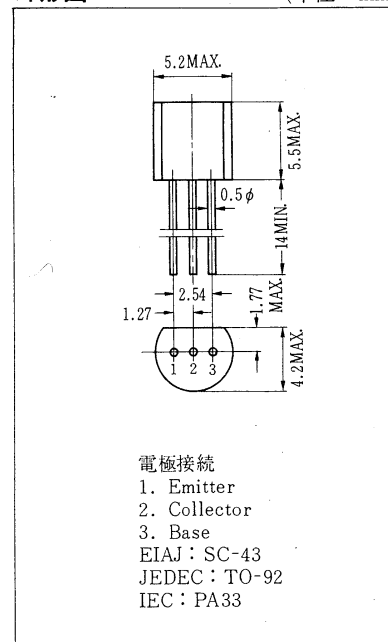
- FM チューナの高周波増幅, 周波数変換, 発振用として最適です。
- 雑音指数が小さい。NF : 3.0dB TYP. ($f=100\text{MHz}$)
- 高利得です。 G_{pe} : 24dB TYP. ($f=100\text{MHz}$)

絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	30	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	20	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5.0	V
コレクタ電流	I_C	20	mA
コレクタ損失	P_C	250	mW
ジャンクション温度	T_j	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+125	$^\circ\text{C}$

外形図

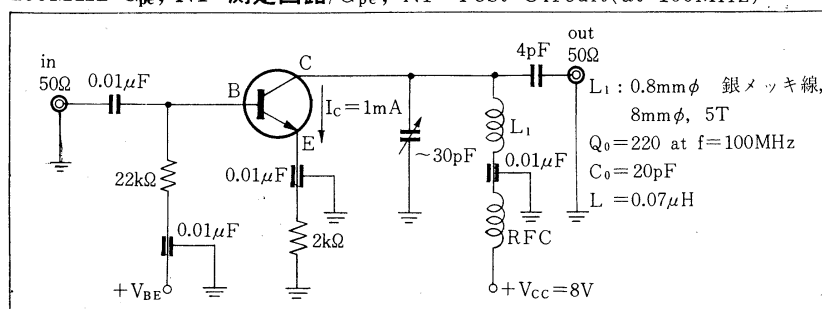
(単位: mm)

電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=20\text{V}, I_E=0$			0.1	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=3.0\text{V}, I_C=0$			0.1	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=6.0\text{V}, I_C=1.0\text{mA}$	40		180	
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=6.0\text{V}, I_E=-1.0\text{mA}$	400	650		MHz
帰還容量	C_{re}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1.0\text{MHz}$		0.85	1.2	pF
$C_c \cdot r_b' b$ 積	$C_c \cdot r_b' b$	$V_{CE}=6.0\text{V}, I_E=-1.0\text{mA}, f=31.9\text{MHz}$		15	22	ps
電力利得	G_{pe}	$V_{CE}=6.0\text{V}, I_C=1.0\text{mA}, f=100\text{MHz}$	20	24		dB
雑音指数	NF	測定回路参照 / See test circuit		3.0	5.0	dB

 h_{FE} 区分

40~80 60~120 90~180

100MHz G_{pe} , NF 測定回路 / G_{pe} , NF Test Circuit (at 100MHz)

特性曲線 (T_a=25°C)

